

半導体関連機器リスト（学内）

2025年5月1日

番号	機器名	メーカー・型式	設置場所	機器情報
半導体プロセス、洗浄				
A001	UV・オゾンクリーナー(CMOS用)	サムコ・Model UV-300	固体機能デバイス	詳細
A002	UV・オゾンクリーナー(センサ/MEMS用)	サムコ・Model UV-1	VBL 1F	詳細
A003	バッチ式Siウエハ洗浄装置	CWC・4+4M	固体機能デバイス	詳細
A004	超臨界洗浄・乾燥装置	レクザム・SCRD4	VBL 1F	詳細
半導体プロセス、成膜				
A005	CMOS用Alスパッタ装置	アネルバ・直流スパッタシステム	固体機能デバイス	詳細
A006	マルチターゲットRF/DCスパッタ装置（CMOS用）	キャノンアネルバ・E-400S	固体機能デバイス	詳細
A007	酸化膜用スパッタ装置	キャノンアネルバ・E-200S	VBL 1F	詳細
A008	イオンコータ	アルバック機工・VPS-050	固体機能デバイス	詳細
A009	VLS結晶成長用金蒸着装置	アネルバ・L-045E	VBL 1F	詳細
A010	プラズマCVD装置（CMOS用）	サムコ・PD-220M	VBL 1F	詳細
A011	プラズマCVD装置（MEMSデバイス用）	サムコ・PD-220NS	VBL 1F	詳細
A012	リフロー用プラズマCVD装置（CMOS用）	サムコ・PD-220NLM	固体機能デバイス	詳細
A013	LPCVD装置（CMOS用）	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	固体機能デバイス	詳細
A014	LPCVD装置（MEMS用）	ディー・エス・アイ・DJ-11S689-M3	固体機能デバイス	詳細
A015	パリレンコータ	日本パリレン・PDS2010	VBL 1F	詳細
A016	高真空蒸着装置	サンバック・Ed-1600	EIIRIS 1F	
A017	機能性絶縁膜堆積装置(PECVD装置)	住友精密工業・Cetus	VBL1F	
半導体プロセス、酸化・熱処理				
A018	CMOS用 酸化・アニール炉	光洋リンドバーグ・MODEL272H-300H15X070H	固体機能デバイス	詳細
A019	水素アニール炉（CMOS用）	光洋サーモシステム・KTF773N-AS	VBL 1F	詳細
A020	水素アニール炉（Si汎用）	光洋リンドバーグ・272M-200H15X070H	固体機能デバイス	詳細
A021	2段酸化炉（Al ₂ O ₃ /Si基板用、Si汎用）	光洋サーモシステム	VBL 1F	詳細
A022	化合物半導体用酸化炉（OEIC用）	光洋サーモシステム・KTF080N-PA WET	VBL 1F	詳細
A023	リン拡散炉	光洋リンドバーグ・272M-200H15X070H	固体機能デバイス	詳細
半導体プロセス、イオン注入				
A024	イオン注入装置	日新イオン機器・EXCEED2300SDV	固体機能デバイス	詳細
半導体プロセス、リソグラフィ				
A025	i線ステッパ	ニコンテック・NSR-TFHi12CH	固体機能デバイス	詳細
A026	コンタクトマスクアライナ（2インチ自動ローディング）	キャノン販売・PLA-501(F)	固体機能デバイス	詳細
A027	コンタクトマスクアライナ（2インチ自動ローディング）	キャノン・PLA-501(F)	固体機能デバイス	詳細
A028	コンタクトマスクアライナ（2インチ手動ローディング）	キャノン・PLA-501	固体機能デバイス	詳細
A029	コンタクトマスクアライナ（4インチ手動ローディング）	キャノン・PLA-600	固体機能デバイス	詳細
A030	両面アライナ	SUSS・Micro Tec AG	固体機能デバイス	詳細
A031	EB描画装置	日本電子・JBX-6300DA	固体機能デバイス	詳細

番号	機器名	メーカー・型式	設置場所	機器 情報
A032	i線用レジスト塗布・現像装置	ASAP・PRD4-000-07-2	固体機能デバイス	詳細
A033	レジストスプレーコーター	ウシオ電機・USC-2000	固体機能デバイス	詳細
A034	レジストアッシング装置（CMOS用）	サムコ・PC-1100	VBL 1F	詳細
A035	レジストアッシング装置（MEMS用）	サムコ・Model PX-250M	VBL 1F	詳細
A036	微細パターン高速形成装置(マスクレス描画装置)	大日本科研・MX-1205	固体機能デバイス	
半導体プロセス、加工・エッチング				
A037	集束イオンビーム加工装置（FIB）	エスアイアイ・ナノテクノロジー・SMI3200TS	VBL 1F	詳細
A038	反応性イオンエッチング装置（MEMS F系ガス用）	サムコ・RIE-200F	VBL 1F	詳細
A039	反応性イオンエッチング装置（MEMS Cl系ガス用）	サムコ・RIE-200NL	VBL 1F	詳細
A040	反応性イオンエッチング装置（CMOS F系ガス用）	アネルバ・L-451D-L	固体機能デバイス	詳細
A041	反応性イオンエッチング装置（CMOS Cl系ガス用）	アネルバ・L-451D-L	固体機能デバイス	詳細
A042	Si深堀りエッチング装置（Deep-RIE）	住友精密工業・MUC21-RD	VBL 1F	詳細
A043	誘導結合型反応性イオンエッチング装置（ICP-RIE）	アルバック・CE-300I	VBL 1F	詳細
A044	Siエッチング装置（XeF2ガス）	Xactix・Xetech E1-β	VBL 1F	詳細
A045	集積化センサ加工装置(ICPRIE装置)	住友精密工業・Sirius	VBL1F	詳細
半導体プロセス、後工程				
A046	Siウエハ用レーザーダイシング装置	東京精密・ML200	固体機能デバイス	詳細
A047	ダイシングソー	東京精密・A-WD-10A	VBL 1F	詳細
A048	ワイヤーボンダー（Au）	ハイソル・West bond 7700D-79	固体機能デバイス	詳細
A049	ワイヤーボンダー（Al）	ハイソル・West bond 7476D	固体機能デバイス	詳細
半導体プロセス、観察・評価				
A050	CLSM：レーザー顕微鏡	オリンパス・OLS3100	固体機能デバイス	詳細
A051	SEM：測長機能付き走査型電子顕微鏡	日本電子・JSM-7100F	固体機能デバイス	詳細
A052	温度可変プローバ・計測器システム	ハイソル	固体機能デバイス	詳細
A053	ウエハプローバ・計測器システム	東京精密・A-PM-50A、 アジレント・4155C	固体機能デバイス	詳細
A054	光干渉膜厚計	大日本スクリーン製造・VM-1230	固体機能デバイス	詳細
加工・エッチング				
A055	FIB：集束イオンビーム装置	日立ハイテクノロジーズ・NB5000	EIIRIS 2F 共同研究 室5	詳細
観察・評価				
A056	CLSM：正立型共焦点顕微鏡	ニコン・A1rsi-TY	EIIRIS 2F バイオ実 験室	詳細
A057	SEM：EDS付走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ・S-3000N: Thermo Fisher・NORAN SYSTEM SIX	EIIRIS 2F 共同研究 室5	詳細
A058	デジタルマイクロ스코プ	キーエンス・VHX-500	EIIRIS 2F 共同研究 室5	詳細
分光分析				
A059	高速イメージング顕微ラマン分光システム	日本分光・NRS-7100	EIIRIS 2F 共同研究 室5	詳細
A060	PL(フォトルミネッセンス)/RAMAN 測定装置	HORIBA Jobin Yvon・LabRAM HR-800	EIIRIS 2F 共同研究 室5	詳細